

КТ3130

кремниевый эпитаксиально-планарный
биполярный n-p-n транзистор

Назначение

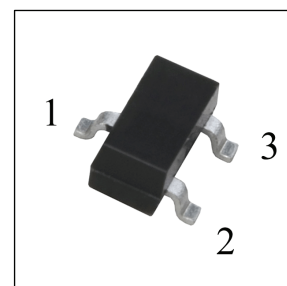
Кремниевый эпитаксиально-планарный биполярный n-p-n транзистор. Предназначен для использования в низкочастотных устройствах радиоэлектронной аппаратуры с малым уровнем шумов, изготавливаемой для народного хозяйства.

Зарубежные прототипы

- BCW71 прототип КТ3130А9
- BCW72 прототип КТ3130Б9
- BCW32 прототип КТ3130В9

Особенности

- рабочий температурный диапазон от - 60 до + 85 °С



Обозначение технических условий

- аАО.336.448ТУ / 02

Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-46А (SOT-23)

Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Коллектор
№2	База
№3	Эмиттер

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ3130

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение коллектор-эмиттер	Укэо гр.	В	Ik=10 мА, Ib=0	15	30
Обратный ток коллектора	Ikбо	мкА	Укб=20-60В, Iэ=0		0.1
Статический коэффициент передачи тока	h _{21э}		Укб=5В, Iэ=2мА	100	1000
Емкость коллекторного перехода	Ск	пФ	Укб=5В, Iэ=0, f=10МГц		12
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Укэ нас	В	Ik=10мА, Ib=1мА		0,3
Граничная частота коэффициента передачи тока	fгр.	МГц	Укб=5В, Iэ=10мА	150	
Коэффициент шума	Кш	дБ	Укэ=5В, Iэ=0,2мА F=1кГц, Rг=2 кОм	4	10

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ3130

Параметры	Обозначение	Единица изм.	Значение
Напряжение коллектор-база	Укб max	В	20-50
Напряжение коллектор-эмиттер	Укэ max	В	15-40
Напряжение эмиттер-база	Уэб max	В	5
Постоянный ток коллектора	Ik max	мА	100
Рассеиваемая мощность коллектора	Pк max	мВт	100
Температура перехода	Tj	°С	125

Таблица 3. Классификация параметров КТ3130

Параметры	КТ3130А9	КТ3130Б9	КТ3130В9	КТ3130Г9	КТ3130Д9	КТ3130Е9	КТ3130Ж9
Укб max, В	50	50	30	20	30	20	30
Укэ max, В	40	40	20	15	20	15	25
h _{21э}	100-250	200-500	200-500	400-1000	200-500	400-1000	100-500
Кш, дБ	-	10	10	10	4	4	-